

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
22. Januar 2004 (22.01.2004) ✓

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/008522 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: H01L 21/60

(74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATENTAN-
WALTSGESELLSCHAFT MBH; Ridlerstr. 55, 80339
München (DE). ✓

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/005859 ✓

(22) Internationales Anmeldedatum:
4. Juni 2003 (04.06.2003) ✓

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 32 190.6 ✓ 16. Juli 2002 (16.07.2002) ✓ DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): AUSTRIAMICROSYSTEMS AG [AT/AT]; Schloss
Premstätten, A-8141 Unterpremstätten (AT). ✓

(72) Erfinder; und

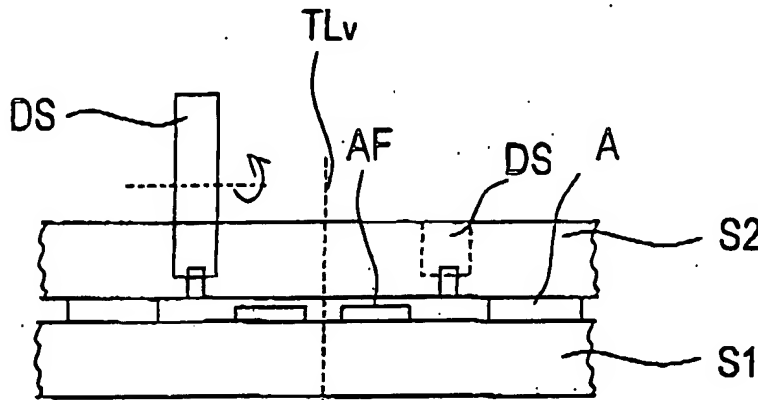
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BRANDL, Manfred
[AT/AT]; Flurgasse 5, A-8112 Gratwein (AT). CSERNIC-
SKA, Robert [AT/AT]; Wiesenstr. 3, A-8510 Stainz (AT).
DRAXLER, Walter [AT/AT]; Grazerstr. 77, A-8430 Neu-
ulmitsch (AT). ✓(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A COMPONENT HAVING SUBMERGED CONNECTING AREAS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BAUELEMENTS MIT TIEFLIEGENDEN ANSCHLUSSFLÄ-
CHEN ✓(57) Abstract: In order to expose
a submerged bondable connecting
area in a component comprising
at least two substrates that are
joined to one another, trenches
of a relatively shallow depth are
provided on the joining surface
of the second substrate before
the substrates are joined. After
joining both substrates, cuts
are made opposite the trenches
thereby opening the same from
the rear side. The cutouts to be
removed are defined between two
trenches.(57) Zusammenfassung: Zum
Freilegen einer tiefliegenden

bondbaren Anschlußfläche in einem zumindest zwei miteinander verbundene Substrate umfassenden Bauelement wird vorgeschlagen, vor dem Verbinden der beiden Substrate auf der Verbindungsoberfläche des zweiten Substrats Gräben relativ geringer Tiefe vorzusehen. Nach dem Verbinden der beiden Substrate werden den Gräben gegenüberliegende, die Gräben von der Rückseite her öffnende Einschnitte erzeugt. Zwischen zwei Gräben werden die zu entfernenden Ausschnitte definiert.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P2002, 0604WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/05859	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 04/06/2003	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 16/07/2002
Anmelder AUSTRIAMICROSYSTEMS AG		

Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem internationalen Büro übermittelt.

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 4 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerisierbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerisierbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerisierbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 4

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ keine der Abb.

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

T/EP 03/05859

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B81B7/00 H01L23/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchiert oder Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
✓ X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 09, 31. Juli 1998 (1998-07-31) -& JP 10 112548 A (DENSO CORP), 28. April 1998 (1998-04-28) Zusammenfassung; Abbildungen 3-17	1-13
✓ P, X	-& US 6 555 901 B1 (YOSHIHARA SHINJI ET AL) 29. April 2003 (2003-04-29) Spalte 2, Zeile 30 - Spalte 8, Zeile 19; Abbildungen 3-17	1-13
✓ X	US 5 668 033 A (KANAMORI KATUHIKO ET AL) 16. September 1997 (1997-09-16) Abbildungen 10-14, 16-19 Spalte 1, Zeile 51 - Zeile 57 Spalte 6, Zeile 15 - Spalte 10, Zeile 13 Spalte 9, Zeile 7 - Zeile 45 --- -/-	1-13



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

3. Februar 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

12/02/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

McGinley, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

T/EP 03/05859

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ERGEBENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
✓ X	WO 01 46664 A (AIGNER ROBERT ;BRAUER MICHAEL (DE); MICHAELIS SVEN (DE); PLOETZ FL) 28. Juni 2001 (2001-06-28) Abbildungen 8-10 Seite 2, Zeile 31 -Seite 7, Zeile 36 Seite 11, Zeile 28 -Seite 13, Zeile 18 ----	1,4-13
✓ X	US 6 407 381 B1 (ARELLANO TONY ET AL) 18. Juni 2002 (2002-06-18) Abbildungen 6-12 Spalte 11, Zeile 5 -Spalte 15, Zeile 9 ----	1,4-13
✓ A	US 5 895 233 A (STRATTON THOMAS G ET AL) 20. April 1999 (1999-04-20) Abbildungen 3-6 -----	1-13

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

T/EP 03/05859

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 10112548	A	28-04-1998	US 6555901 B1	29-04-2003
US 5668033	A	16-09-1997	JP 8316497 A	29-11-1996
			DE 19619921 A1	05-12-1996
WO 0146664	A	28-06-2001	DE 19962231 A1	12-07-2001
			WO 0146664 A2	28-06-2001
			EP 1240529 A2	18-09-2002
			JP 2003517946 T	03-06-2003
			US 2002170175 A1	21-11-2002
US 6407381	B1	18-06-2002	TW 501243 B	01-09-2002
US 5895233	A	20-04-1999	CA 2179052 A1	22-06-1995
			DE 69409257 D1	30-04-1998
			DE 69409257 T2	10-09-1998
			EP 0734589 A1	02-10-1996
			JP 9506712 T	30-06-1997
			WO 9517014 A1	22-06-1995

Rec'd PCT/PTO 14 JAN 2005 EP03/05859

PATENT COOPERATION TREATY

10/521322

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)EPPING HERMANN FISCHER
PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH
Ridlerstr. 55
80339 München
Germany

Date of mailing (day/month/year) 15 September 2003 (15.09.03)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference P2002,0604WO	
International application No. PCT/EP03/05859	International filing date (day/month/year) 04 June 2003 (04.06.03)

1. The following indications appeared on record concerning:									
<input type="checkbox"/> the applicant	<input type="checkbox"/> the inventor <input checked="" type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative								
Name and Address EPPING HERMANN & FISCHER Ridlerstr. 55 80339 München Germany	<table border="1"> <tr> <td>State of Nationality</td> <td>State of Residence</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Telephone No. ++49-89-500329-0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Facsimile No. ++49-89-500329-99</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teleprinter No.</td> </tr> </table>	State of Nationality	State of Residence	Telephone No. ++49-89-500329-0		Facsimile No. ++49-89-500329-99		Teleprinter No.	
State of Nationality	State of Residence								
Telephone No. ++49-89-500329-0									
Facsimile No. ++49-89-500329-99									
Teleprinter No.									
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:									
<input type="checkbox"/> the person <input checked="" type="checkbox"/> the name <input type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence									
Name and Address EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH Ridlerstr. 55 80339 München Germany	<table border="1"> <tr> <td>State of Nationality</td> <td>State of Residence</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Telephone No. ++49-89-500329-0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Facsimile No. ++49-89-500329-99</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teleprinter No.</td> </tr> </table>	State of Nationality	State of Residence	Telephone No. ++49-89-500329-0		Facsimile No. ++49-89-500329-99		Teleprinter No.	
State of Nationality	State of Residence								
Telephone No. ++49-89-500329-0									
Facsimile No. ++49-89-500329-99									
Teleprinter No.									
3. Further observations, if necessary:									
4. A copy of this notification has been sent to:									
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input type="checkbox"/> the designated Offices concerned								
<input checked="" type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input type="checkbox"/> the elected Offices concerned								
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:								

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer M-Chr. GUILLEMOT (Fax 338 8970)
Facsimile No. (41-22) 338.89.70	Telephone No. (41-22) 338 8838

P2002,0604

10/521322
DT1 SUPPCT/PTO 14 JAN 2005

1

Beschreibung

Verfahren zur Herstellung eines Bauelements mit tiefliegenden Anschlußflächen

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung tiefliegender bondbarer Anschlußflächen bei einem Bauelement, welches zumindest zwei miteinander verbundene Substrate umfaßt.

- 10 Aus der Druckschrift WO 98/05935 A1 ist bekannt, daß Sensoren so auf ein Substrat aufgebracht werden können, daß die Sensorelemente über einer Öffnung im Substrat angeordnet sind. Aus der Druckschrift JP 2000195827 A bzw. dem Zitat in Patent Abstracts of Japan ist bekannt, auf einer Seite eines Substrats
- 15 Gräben einzubringen und zur Vereinzelung der auf einem Wafer ausgebildeten LED-Bauelemente von der Rückseite des Substrats her über den Gräben Einschnitte bis zu einer solchen Tiefe zu erzeugen, daß die Gräben geöffnet werden. Aus der Druckschrift JP 09223678 A ist bekannt, daß bei zwei miteinander
- 20 verbundenen Substraten zur Vereinzelung der Bauelemente Ausschnitte aus einem zweiten Substrat entfernt werden.

- Bauelemente, die in zwei miteinander verbundenen Substraten realisiert sind, sind beispielsweise sogenannte COC (chip on
- 25 chip) Bauelemente, die eine Art vertikaler Integration aufweisen. Die beiden Substrate, die beide Bauelementstrukturen aufweisen können, werden über zwei Hauptoberflächen miteinander verbunden, wobei gleichzeitig, falls erforderlich, ein elektrischer Kontakt zwischen Bauelementstrukturen in unterschiedlichen Substraten hergestellt werden kann. Das Bauelement kann gemeinsame oder getrennte elektrische Kontakte für
- 30 beide verbundene Substrate aufweisen. Sind auf beiden Substraten elektrische Kontakte vorgesehen, so kann die wechselseitige elektrische Verbindung der in den beiden Substraten
- 35 realisierten Bauelementstrukturen auch über Bonddrähte zwischen den jeweiligen Kontakte erfolgen.

P2002,0604

2

- Die COC-Technologie wird insbesondere zur Verkapselung von Bauelementen auf Chip Ebene eingesetzt, auch "first level packaging" genannt. Sie wird auch da verwendet, wo eine weitere Miniaturisierung der Bauelemente angestrebt wird und insbesondere Bauelemente mit vermindertem Flächenbedarf auf einer Platine oder in einem Modul gesucht werden. Die Technologie wird insbesondere angewandt zur Herstellung von ICs, mikromechanischen Bauelementen oder Sensoren (MEMS) oder auch zur Herstellung mikrooptischer Bauelemente.
- Die Substrate der COC-Bauelemente werden üblicherweise mittels integrierter Verfahren auf Wafer-Ebene hergestellt, wobei auch die Verbindung der beiden Bauelementsubstrate auf Wafer-Ebene erfolgt. Es ist daher erforderlich, auf dem unteren der beiden Substrate, oder, bei mehreren Substraten, auf einem unteren Substrat nach dem Verbinden der beiden Substrate die elektrischen Anschlußflächen freizulegen und dazu beispielsweise ein Fenster in dem oberen Substrat zu erzeugen. Wird das Fenster nach dem Verbinden der beiden Substrate erzeugt, so besteht die Gefahr, daß durch den Fensteröffnungsprozeß zur Freilegung der Kontakte (Anschlußflächen) diese oder andere Strukturen auf dem unteren der beiden Substrate beschädigt oder gar zerstört werden.
- Bekannt und üblich ist es daher, die Fenster, in denen die Anschlußflächen freiliegen, im oberen der beiden Wafer vor dem Verbinden der Substrate auszubilden. Bei Halbleiterwafern kann das beispielsweise durch anisotropes Ätzen von einer oder zwei Seiten des oberen Wafers erfolgen. Als Ätztechnik kann beispielsweise reaktives Ionenätzen eingesetzt werden. Nachteilig an dem Verfahren ist jedoch, daß das obere Substrat durch die vorgefertigten Fenster instabil wird, da mit den Fenstern mögliche Bruchstellen bereits vorgegeben sind. Dies ist insbesondere für das Verbinden der beiden Wafer von Nachteil, welches insbesondere unter Druck erfolgt. Dies hat zur Folge, daß die COC-Technologie, bei der zwei Substrate durch Bonden miteinander verbunden werden, auf der Wafer-

P2002,0604

3

Ebene auf Wafer von vier bis maximal sechs Zoll Durchmesser beschränkt ist. Ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens ist, daß das ortsgenaue Durchätzen der Fenster einen hohen Zeit- und Verfahrensaufwand erfordert.

5

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, insbesondere für die COC-Technologie ein Verfahren anzugeben, welches eine einfachere Freilegung tiefliegender Anschlußflächen bei Bauelementen ermöglicht, die zumindest zwei miteinander verbundene Substrate umfassen.

10

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus weiteren Ansprüchen hervor.

15

Im Gegensatz zu dem bekannten Verfahren, bei dem die Fenster im oberen Substrat vor dem Verbinden der beiden Substrate durch Ätzen in einem aufwendigen Schritt erzeugt werden, wird die Freilegung der Anschlußflächen erfindungsgemäß in zwei Schritten durchgeführt.

20

Ein erster Schritt, der vor dem Verbinden der Substrate durchgeführt wird, besteht in dem Erzeugen von Gräben in der Oberfläche des zweiten (oberen) Substrats. Diese Gräben definieren und begrenzen einen Ausschnitt, in dem später die Anschlußflächen des ersten bzw. unteren Substrats freigelegt werden. Die Gräben werden bis zu einer vorgegebenen Tiefe erzeugt, die nur einem Bruchteil der gesamten Substratdicke entspricht.

30

Das erste Substrat, das auf seiner Oberfläche die genannten Anschlußfläche für im ersten Substrat angeordnete Bauelementstrukturen aufweist, wird anschließend so mit dem zweiten (oberen) Substrat verbunden, daß die Oberfläche des zweiten Substrats mit den Gräben zu der die Anschlußflächen aufweisenden Oberfläche des ersten Substrats weist.

35

P2002,0604

4

Anschließend werden von der Rückseite des zweiten oberen Substrats her im Bereich über den Gräben Einschnitte erzeugt, die bis zu einer solchen Tiefe reichen, daß in den Einschnitten die Gräben über ihre gesamte Länge geöffnet werden. Vorzugsweise werden die Einschnitte dazu parallel zu den Gräben bzw. direkt über den Gräben und dem Verlauf der Gräben folgend erzeugt.

Das erfindungsgemäße Verfahren hat den Vorteil, daß die Stabilität des oberen Wafers durch die nur geringe Tiefe der Gräben eine ausreichende Stabilität behält, die gegenüber dem bekannten Verfahren das Risiko eines Substrat- oder Waferbruchs erheblich erniedrigt. Des weiteren hat das Verfahren den Vorteil, daß der aufwendigere Teilschritt des Verfahrens, nämlich das Erzeugen der Gräben, wegen deren geringen Tiefe wesentlich schneller und weniger aufwendig durchgeführt werden kann. Das Erzeugen der Einschnitte von der Rückseite dagegen kann nun mit einem kostengünstigeren, einfacheren und gegebenenfalls unpräziseren Verfahren erfolgen, beispielsweise durch Einsägen.

Nach dem Öffnen der Gräben in den Einschnitten ist das zweite Substrat im Bereich des Ausschnitts durchtrennt, so daß der Ausschnitt entfernt werden kann, wobei das gewünschte Fenster entsteht, in dem die Anschlußflächen freigelegt sind.

Wird zum Erzeugen der Einschnitte ein Sägeverfahren eingesetzt und beispielsweise eine Diamantsäge verwendet, so ist es von Vorteil, die Einschnitte als geradlinige Schnitte zu erzeugen. Dementsprechend werden auch gradlinige Gräben in der gegenüberliegenden Oberfläche des zweiten Substrats vorgesehen. Dazu passend werden vorzugsweise die Anschlußflächen in einer Reihe nebeneinander angeordnet, so daß sich mit einem einzigen Ausschnitt bzw. mit zwei Einschnitten ein langgestrecktes, über das gesamte Substrat reichendes Fenster öffnen läßt, in dem eine oder mehrere Reihe von Anschlußflächen in einem Schritt freigelegt werden können. Eine Reihe

P2002,0604

5

von Anschlußflächen kann zu einem oder mehreren, nebeneinander auf dem ersten Substrat angeordneten Bauelementen gehören.

- 5 Die Herstellung der Gräben kann in einem beliebigen Verfahren erfolgen, welches strukturiert und kontrolliert so durchgeführt werden kann, daß ortsgenaue Gräben einer gewünschten Grabentiefe erzeugt werden können. Möglich ist es beispielsweise, die Gräben über eine Resist-Maske zu definieren, die
10 photolithographisch strukturiert wird. Mit der Resist-Maske wird anschließend ein strukturierter Ätzprozeß durchgeführt, bei dem in den nicht von der Resist-Maske bedeckten Bereichen Material entfernt wird, bis eine gewünschte oder vorgegebene Grabentiefe erreicht ist. Als Ätzverfahren kann naßchemisches
15 Ätzen, Ionenstrahlätzen oder plasmaunterstütztes Ätzen verwendet werden. Das Ätzen kann isotrop oder anisotrop erfolgen, da Grabenprofil und Grabenbreite nahezu keinen Einfluß auf die Qualität des mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erzeugten Bauelement haben. Trotzdem sind anisotrope Verfahren
20 bevorzugt, da in solchen Verfahren weniger Material entfernt werden muß, was den Aufwand für den Ätzprozeß verringert.

- Die Breite der Gräben hat deswegen keinen Einfluß auf das Verfahrensergebnis, da die Gräben lediglich zur Definition
25 zur Ausschnitts dienen und da in den Gräben lediglich eine Auftrennung des Substrats bis zur Grabentiefe erfolgen muß. Von Vorteil ist eine solche Grabenbreite, die ein sicheres Auftrennen bis zur gewünschten Tiefe erzeugt, damit nach dem Herstellen der Einschnitte keine Materialbrücken zwischen dem
30 Ausschnitt und dem verbleibenden Substrat bestehen bleiben.

- Vorteilhafterweise werden Maßnahmen vorgesehen, die ein leichtes Ablösen bzw. das vollständige Entfernen des Ausschnitts, also des Bereichs des zweiten Substrats, der zwischen den Gräben definiert ist und der das Fenster zum Freilegen der Anschlußflächen bildet, gewährleisten. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, über den Anschlußflächen einen
35

P2002,0604

6

Freiraum vorzusehen, der auch nach dem Verbinden der beiden Substrate für einen lichten Abstand zwischen Anschlußflächen und der benachbarten Oberfläche des zweiten Wafers sorgt. Zur Gewährleistung eines solchen lichten Abstands kann in zumindest einem der beiden Substrate auf einer der zueinander weisenden Oberflächen eine Struktur erzeugt werden, die als Abstandshalter jenseits des Fensters dient. Möglich ist es auch, unter den Anschlußflächen im ersten Substrat oder über den Anschlußflächen im zweiten Substrat eine entsprechende Vertiefung vorzusehen.

Eine weitere Möglichkeit, das vollständige Entfernen des Ausschnitts zu erleichtern, besteht darin, über den Anschlußflächen im Bereich des Ausschnitts eine Abdeckung vorzusehen, die beim Verbinden der beiden Substrate ein direktes Anhaften des zweiten Substrats an den Anschlußflächen verhindert. Vorzugsweise verwendet man dazu solche Abdeckungen, die sich nach dem Öffnen des Ausschnitts leicht entfernen lassen und die daher keine oder eine nur geringe Haftung zu den beiden Substraten aufweisen sollten. Als Abdeckung geeignet sind daher insbesondere solche Schichten oder Schichtmaterialien, die nur geringe Adhäsionskräfte auf dem Substrat ausbilden oder die eine Schicht von nur geringem inneren Zusammenhalt erzeugen, so daß eine einfache Entfernung des Ausschnitts möglich ist.

Prinzipiell ist es auch möglich, solche Verfahren zum Verbinden der beiden Substrate einzusetzen, die gezielt und selektiv nur an gewünschten Verbindungsflächen zum Herstellen einer festen Verbindung zwischen den beiden Substraten führen. Dazu gehören insbesondere solche Verfahren, bei denen ein Verbindungsmaterial zum Herstellen der Verbindung auf eines der beiden Substrate aufgebracht wird. Dies sind beispielsweise Glasbonden, Bonden über Bumps, eudektisches Bonden und teilweise auch anodisches Bonden. Bei diesen Verbindungsverfahren ist es nicht erforderlich, einen lichten Abstand der beiden Substrate über den Anschlußflächen zu gewährleisten

P2002,0604

7

oder eine Abdeckschicht über den Anschlußflächen vorzusehen. Diese Verfahren können so durchgeführt werden, daß die Verbindungsstellen beider Substrate außerhalb der für die Anschlußflächen vorgesehenen Oberflächen der Substrate erfolgt.

5 Zum Verbinden der beiden Substrate ist auch ein Klebstoff geeignet sowie, wenn die Substrate Halbleitermaterial umfassen, ein Direktbonden dieser Halbleitermaterialien. Dazu werden diese hoher Temperatur ausgelagert, wobei eine feste Verbindung der dabei miteinander in Kontakt tretenden Halbleiter-
10 oberflächen erzeugt wird.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und der dazugehörigen Figuren näher erläutert. Die Figuren stellen nur schematische Darstellungen dar, sind
15 nicht maßstabsgetreu ausgeführt und können die Erfindung nur auszugsweise anhand der speziellen Ausführungsbeispiele wiedergeben.

20 Figur 1 zeigt ein bekanntes COC-Bauelement im schematischen Querschnitt,

Figur 2 zeigt zwei zu verbindende Substrate im schematischen Querschnitt,

25 Figur 3 zeigt die Anordnung der Gräben auf dem zweiten Substrat,

Figur 4 zeigt das Bauelement während der Herstellung der Einschnitte im schematischen Querschnitt,

30 Figur 5 zeigt das Bauelement nach den Einschnitten,

Figur 6 zeigt die auf dem ersten Substrat freigelegten Anschlußflächen in der Draufsicht,

35 Figur 7 zeigt ein Einzelbauelement nach Vereinzelung..

P2002,0604

8

In Figur 1 ist ein an sich bekanntes Chip-on-Chip-Bauelement im schematischen Querschnitt dargestellt. Das Bauelement ist aus einem ersten Substrat S1 und einem damit verbundenen zweiten Substrat S2 aufgebaut, die mit an sich bekannten Bondtechnologien verbunden sind. Zumindest das untere erste Substrate S1 enthält Bauelementstrukturen, deren elektrischer Anschluß zur Außenwelt über die Anschlußfläche AF auf der Oberseite des unteren Substrats S1 erfolgt. Damit dieses in dem Zweischicht-Bauelement von außen zugänglich ist, weist das zweite Substrat S2 im Bereich der Anschlußfläche AF ein Fenster auf, in dem die Anschlußfläche AF freigelegt ist. Das Fenster im zweiten Substrat S2 wird vor dem Verbinden der beiden Substrate mittels Ätztechnologien erzeugt.

Figur 2: Gemäß der Erfindung wird in einem aus zumindest einem ersten Substrat S1 und einem zweiten Substrat S2 bestehenden Bauelement wie folgt vorgegangen. Im zweiten Substrat S2 werden mit einer Ätztechnik Gräben G erzeugt. Zwischen zwei gradlinigen Gräben oder innerhalb einer kreisförmig geschlossenen Grabenstruktur wird ein Ausschnitt AS definiert, der der Größe des später zu öffnenden Fensters entspricht. Auf der Oberfläche des ersten Substrats S1 sind Anschlußflächen AF vorgesehen, beispielsweise lötfähige Kontakte. Zumindest eines der beiden Substrate weist auf einer der zu verbindenden Oberflächen eine Abstandsstruktur A auf, welche im vorliegenden Fall beispielsweise die Verbindungsstelle zwischen den beiden Substraten S1 und S2 darstellt. Die Abstandsstruktur A kann beispielsweise ein Bump, eine Metallisierung zum eutektischen Bonden oder ein Klebstoffauftrag sein. Die Abstandsstruktur A kann durch Strukturieren der Oberfläche eines der Substrate erfolgen. Dazu wird eine der Substratoberflächen durch Ätzen so strukturiert, daß an den zum Bonden vorgesehenen Stellen ein geeignetes höheres Niveau gegenüber der restlichen Substratoberfläche entsteht.

35

Figur 3 zeigt das Substrat S2 in der Draufsicht auf die Oberfläche, in der die Gräben G angeordnet sind. In dem Substrat,

P2002,0604

9

in dem mehrere Einzelbauelemente realisiert sind, sind die Grenzen zwischen den zukünftigen Einzelbauelemente durch gestrichelte Trennlinien TL_h und TL_v gekennzeichnet. Die Gräben G verlaufen vorzugsweise gradlinig über das gesamte Substrat und sind paarweise so angeordnet, daß sie einen streifenförmigen Ausschnitt AS zwischen sich definieren. Der streifenförmige Ausschnitt AS ist vorzugsweise direkt über einer Trennlinie TL_v angeordnet, so daß der Ausschnitt AS die Randbereiche von jeweils zwei benachbarten Einzelbauelementen überdeckt. Mit der in Figur 3 dargestellten Strukturierung wird in jedem Einzelbauelement nur ein streifenförmiger Ausschnitt AS erzeugt. Möglich ist es jedoch auch, zwei und mehr dieser Ausschnitte pro Einzelbauelement zu erzeugen, wenn eine höhere Anzahl von Anschlußflächen darin freizulegen ist.

Nach dem Erzeugen der Gräben G werden die beiden Substrate S1 und S2 nach einem an sich bekannten Verfahren, insbesondere einem Wafer-Bondverfahren oder durch Kleben, miteinander verbunden. In dem in der Figur 4 dargestellten Beispiel erfolgt die Verbindung über die Strukturen A. Möglich ist es jedoch auch, die Verbindung beider Substrate großflächig vorzunehmen und dazu insbesondere die Anschlußflächen AF in einer Vertiefung anzuordnen. Möglich ist es auch, im zweiten Substrat S2 über den Anschlußflächen AF eine Vertiefung vorzusehen.

Mit Hilfe einer Säge, beispielsweise einer Diamantsäge DS, die in der Figur nur schematisch als rotierende Scheibe dargestellt ist, wird nun von der den Gräben gegenüberliegenden Rückseite des zweiten Substrats S2 her ein Einschnitt ES über den Gräben G erzeugt. Der Einschnitt ES wird bis zu einer solchen Tiefe geführt, bis der jeweilige Graben von der Rückseite her geöffnet ist. Auf diese Weise wird das zweite Substrat S2 parallel zu den Gräben vollständig aufgetrennt.

Die zweistufige Durchführung der Auftrennung hat den Vorteil, daß die Erzeugung der Einschnitte mit einem wesentlich ungenaueren Werkzeug vorgenommen werden kann, welches alleine we-

P2002,0604

10

gen der relativ hohen Abweichung bezüglich der Einschnitttiefe zur Durchführung der Auftrennung nicht einsetzbar wäre. Zur Bemessung der Grabentiefe ergibt sich daher als Untergrenze, daß die Grabentiefe zumindest dem Toleranzwert entsprechen sollte, der dem Werkzeug zur Erzeugung der Einschnitte, insbesondere der Diamantsäge DS, entspricht. Sofern aufgrund einer besonderen Ausgestaltung der Oberflächentopologie der beiden Substrate auf der Verbindungsseite zwischen der Oberkante der Gräben im zweiten Substrat und der darunterliegenden Oberfläche des ersten Substrats ein ausreichender lichter Abstand gegeben ist, kann die Tiefe des Grabens um diesen Betrag vermindert werden. Hochwertige heutzutage verwendete Diamantsägen DS weisen eine Toleranz bezüglich der Einschnitt-Tiefe von mehr als 20 μm , üblicherweise 50 - 60 μm , auf. Daraus folgt, daß die Tiefe der Gräben vorzugsweise dem höchsten einzuhaltenden Toleranzwert der Säge entspricht. Wenn beide Substrate S1, S2 Halbleiterwafer darstellen, die beispielsweise eine Dicke von 500 μm aufweisen, so beträgt die erforderliche Grabentiefe für die genannten hochwertigen Sägen beispielsweise nur ca. 10 % der Schichtdicke. Dies führt zu einer nur unwesentlichen Beeinträchtigung der Stabilität des Wafers. Die höhere mechanische Stabilität der erfindungsgemäßen Substrate S ermöglicht es dann, zur Herstellung von COC-Bauelementen oder besser allgemein von stacked Wafer-Bauelementen größere Wafer einzusetzen, ohne daß eine höhere Bruchgefahr während des Herstellungs- und Bearbeitungsverfahrens, insbesondere beim Wafer-Bonden zu befürchten ist. Der zweite Einschnitt ES ist in der Figur nur durch gestrichelte Linien dargestellt.

30

Aus der Figur ergibt sich direkt ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Schnittbreite bei der Herstellung der Einschnitte kann beliebig groß gewählt werden, wodurch sich die Justierung der Einschnitte relativ zu den Gräben erleichtert. Möglich ist es sogar, zur Herstellung der Einschnitte ein Werkzeug zu verwenden, dessen Schnittbreite der Breite des Ausschnitts, also der Entfernung der Gräben

35

P2002,0604

11

voneinander, entspricht. Auf diese Weise genügt für einen Ausschnitt ein einziger Einschnitt, um das Fenster zur Freilegung der Anschlußflächen AF zu öffnen. Die genannten Diamentsägen DS haben jedoch üblicherweise nur eine Schnittbreite von ca. 30 - 100 μm , während eine nach heutiger Drahtbond-
5 technik ausreichende Breite des Ausschnitts AS zumindest 0,5 mm betragen sollte, vorzugsweise jedoch 1 bis 3 mm.

Nach dem Fertigstellen der Einschnitte ist der dem Ausschnitt AS entsprechende Substratstreifen völlig vom restlichen Substrat S2 gelöst und kann entfernt werden. In dem dadurch entstehenden Fenster F sind, wie in Figur 5 im schematischen Querschnitt dargestellt, nun die Anschlußflächen AF freigelegt und aufgrund der geeigneten Breite des Ausschnitts AS
10 für einen Lötvorgang gut zugänglich. In der Figur sind im Fenster F zwei Anschlußflächen angeordnet, die unterschiedlichen Bauelementen zugehörig sind und entsprechend durch Indizes A und B gekennzeichnet sind. Die Trennlinie TL_v, entlang der später die beiden Bauelemente getrennt werden, ist durch
15 gestrichelte Linien eingezeichnet.
20

Figur 6 zeigt die Anordnung in dieser Verfahrensstufe in der Draufsicht. Im gewählten Ausschnitt des insgesamt größeren Bauelementes ist eine Kreuzung zweier Trennlinien TL_v, TL_h angeordnet, so daß hier die aneinanderstoßenden Ecken vierer Einzelbauelemente dargestellt sind. Pro Einzelbauelement kann eine beliebige, vom Bauelementtyp abhängige Anzahl von Anschlußflächen AF vorgesehen sein. Pro Wafer (Substrat) kann eine im Wesentlichen von der Größe der Einzelbauelemente be-
25 grenzte, ansonsten aber beliebige Anzahl Einzelbauelemente vorgesehen sein.
30

Auf dieser Stufe ist es nun bereits möglich, die Einzelbauelemente auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu testen und dazu
35 insbesondere die Anschlußflächen AF mit entsprechenden Kontakten zu versehen. Möglich ist es jedoch auch, die Bauelemente direkt zu vereinzeln. Dies kann in zwei Stufen erfol-

P2002,0604

12

gen, wobei die Anordnung mit Hilfe eines geeigneten Trennwerkzeugs, beispielsweise der genannten Diamantsäge, entlang den Trennlinien TL einer Sorte, beispielsweise TL_v, zu einzelnen Streifen aufgeteilt werden, wobei jeder Streifen eine
5 Reihe von miteinander verbundenen Bauelementen enthält. Auch auf dieser Stufe kann der elektrische Test der Einzelbauelemente erfolgen, bevor abschließend die Auftrennung in Einzelbauelemente entlang der zweiten Trennlinien TL_n erfolgt.

10 Figur 7 zeigt ausschnittsweise ein Einzelbauelement nach dem Vereinzeln. Gut zu erkennen ist, daß die Anschlußflächen AF im Randbereich des jeweiligen Bauelements bzw. dessen ersten Substrats benachbart sind. Weiterhin ist dargestellt, wie die
15 Anschlußflächen mit Hilfe einer metallischen Verbindung, beispielsweise eines Bumps BP mit einem Bonddraht BD verbunden und nach außen kontaktiert werden, beispielsweise auf einer Platine. Die Anordnung der Anschlußflächen AF am Rand hat den Vorteil, daß der Bonddraht berührungsfrei von den Kanten des zweiten Substrats S2 geführt werden kann. Sind auf dem zwei-
20 ten Substrat S2 weitere Kontakte für Bauelementstrukturen innerhalb des zweiten Substrats vorgesehen, so wird hiermit die Gefahr eines ungewollten Kurzschlusses ausgeschlossen.

Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens können die tief-
25 liegenden Anschlußflächen verschiedenster Bauelemente freigelegt werden, die während der Herstellung unter zwei großflächig miteinander verbundenen Substraten ursprünglich verdeckt waren. Dementsprechend kann das Bauelement in nur einem Substrat, insbesondere im ersten Substrat S1, ausgebildet sein
30 und das zweite Substrat S2 daher beispielsweise eine Abdeckung für das Bauelement darstellen. In allen Fällen handelt es sich bei den beiden Substraten um keramische, glasartige oder kristalline, in jedem Fall aber starre, großflächige feste Körper. In Hohlräumen, die zwischen den beiden Substraten
35 S1 und S2 gebildet sein können, kann außerdem ein Vakuum oder eine beliebige Gasatmosphäre eingeschlossen sein. Zumindest eines der beiden Substrate kann außerdem mikromechanische

P2002,0604

13

oder mikrooptische Bauelementstrukturen aufweisen. Vorzugsweise ist das Bauelement daher ein IC, ein Sensor, ein MEMS Sensor für Druck, Beschleunigung oder Drehrate, ein mikrooptisches Bauelement wie beispielsweise eine Photosensorarray mit einer Glasabdeckung oder ein beliebiges anderes, zwei miteinander verbundene Substrate umfassendes Bauelement.

In einer nicht dargestellten weiteren Ausführungsform der Erfindung weist das Bauelement einen aus mehr als zwei übereinandergestapelten Substraten bestehenden Aufbau auf. Das dritte und weitere Substrate können auf der Oberfläche des ersten oder des zweiten Substrats aufgebracht sein. Vorzugsweise werden die weiteren Substrate zwischen den in den Figuren 2 und 4 dargestellten Verfahrensstufen mit einem der beiden anderen Substrate oder dem Verbund der beiden Substrate verbunden. Ein ganzflächig auf dem zweiten Substrat S2 aufliegendes drittes oder weiteres Substrat kann erfindungsgemäß zusammen mit dem zweiten Substrat eine Einheit bilden, die wie ein einziges zweites Substrat behandelt wird und beim Herstellen der Einschnitte ES vollständig durchtrennt wird.

P2002,0604

14

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von tief liegenden bondbaren Anschlußflächen (AF) bei einem zumindest zwei miteinander verbundene Substrate (S1,S2) umfassenden Bauelement,
- bei dem ein erstes, elektrisch leitende Bauelementstrukturen umfassendes Substrat (S1) vorgesehen wird, wobei die Bauelementstrukturen mit den genannten Anschlußflächen (AF), die auf einer Oberfläche des ersten Substrats (S1) angeordnet sind, elektrisch verbunden sind,
 - bei dem in einer Oberfläche eines zweiten Substrats (S2) Gräben (G), die zumindest einen Ausschnitt (AS) begrenzen, mit einer vorgegebenen Tiefe erzeugt werden,
 - bei dem das erste und das zweite Substrat so miteinander verbunden werden, daß die mit den Anschlußflächen und den Gräben versehenen Oberflächen der beiden Substrate zueinander weisen,
 - bei dem von der nun außen liegenden Rückseite des zweiten Substrats her über den Gräben Einschnitte (ES) bis zu einer solchen Tiefe erzeugt werden, daß dort die Gräben (G) geöffnet werden,
 - bei dem der zumindest eine Ausschnitt (AS) entfernt wird, damit die Anschlußflächen (AF) freigelegt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Gräben (G) und die den Gräben folgenden Einschnitte (ES) geradlinig über das gesamte zweite Substrat (S2) verlaufend hergestellt werden, bei dem die Einschnitte durch Sägen erzeugt werden, und bei dem zwischen jeweils zwei Gräben ein Ausschnitt (AS) zum Freilegen der Anschlußflächen (AF) definiert ist.
3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem jeweils mehrere Anschlußflächen (AF) des ersten Substrats (S1) in einer Reihe nebeneinander angeordnet werden und bei dem jeweils einer der Ausschnitte (AS) eine der Reihen von Anschlußflächen (AF) freilegt.

P2002,0604

15

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem die Gräben (G) durch naßchemisches Ätzen, Ionen-
strahl- oder Plasmaätzen erzeugt werden.

5

5. Verfahren nach Anspruch 4,
bei dem die Gräben (G) über eine Resistmaske definiert wer-
den, die photolithographisch strukturiert wird.

10 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem die Gräben (G) durch Laserschneiden erzeugt werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei dem die Gräben (G) bis zu einer Tiefe erzeugt werden, die
15 größer ist, als die Schnitttiefengenauigkeit des Sägeverfah-
rens beim Erzeugen der Einschnitte (ES).

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei dem vor dem Verbinden der Oberflächen der beiden Substra-
20 te (S1,S2) zumindest eine der Oberflächen so ausgebildet
wird, daß nach dem Verbinden über den Anschlußflächen (AF)
ein lichter Freiraum mit Abstand zur entsprechenden Oberflä-
chen des zweiten Substrats (S2) geschaffen wird.

25 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei dem vor dem Verbinden der Oberflächen auf dem ersten Sub-
strat (S1) zumindest über den Anschlußflächen (AF) oder unter
dem späteren Ausschnitt (AS) des zweiten Substrats (S2) eine
Abdeckung erzeugt wird, so daß beim Verbinden ein direktes
30 Anhaften des zweiten Substrats an den Anschlußflächen verhin-
dert wird, und bei dem die Abdeckung nach dem Erzeugen des
Ausschnitts wieder entfernt wird.

10.Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
35 bei dem das Verfahren zum Verbinden der Substrate (S1,S2) ei-
nes der folgenden Maßnahmen umfaßt: Glasbonden, Bonden über
Bumps, Anodisches Bonden, Eutektisches Bonden, Direktbonden

P2002,0604

16

von aus Halbleitermaterial bestehenden Substratoberflächen
oder Kleben.

11.Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

- 5 bei dem Wafer als Substrate (S1,S2) eingesetzt werden, wobei
zumindest im ersten Substrat mehrere Bauelemente ausgebildet
werden, die nach dem Freilegen der Anschlußflächen (AF) ver-
einzelt werden.

10 12.Verfahren nach Anspruch 11,

bei dem die Anschlußflächen (AF) jedes Bauelements in Reihen
angeordnet werden, die zu Kanten des einzelnen Bauelements
direkt benachbart sind, wobei die Reihen direkt benachbarter
Bauelemente nebeneinander verlaufen und

- 15 bei dem in einem Ausschnitt (AS) jeweils die zwei benachbar-
ten Reihen von Anschlußflächen benachbarter Bauelemente frei
gelegt werden.

13.Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,

- 20 bei dem in zumindest einem der Substrate (S1,S2) mikroelek-
trische, mikrooptische oder mikromechanische Bauelemente
oder kombinierte Bauelemente der genannten Typen realisiert
werden.

P2002,0604

17

Zusammenfassung

Verfahren zur Herstellung eines Bauelements mit tiefliegenden Anschlußflächen .

5

Zum Freilegen einer tiefliegenden bondbaren Anschlußfläche in einem zumindest zwei miteinander verbundene Substrate umfassenden Bauelement wird vorgeschlagen, vor dem Verbinden der beiden Substrate auf der Verbindungsoberfläche des zweiten Substrats Gräben relativ geringer Tiefe vorzusehen. Nach dem Verbinden der beiden Substrate werden den Gräben gegenüberliegende, die Gräben von der Rückseite her öffnende Einschnitte erzeugt. Zwischen zwei Gräben werden die zu entfernenden Ausschnitte definiert.

15

Figur 4